



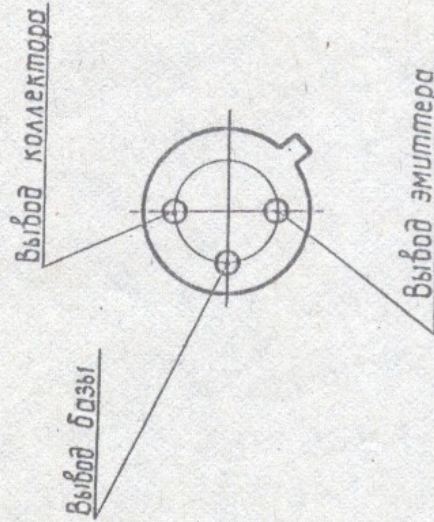
Транзистор 2Т830

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-плоскостные р-п-р транзисторы типов 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г в металлотеклинном корпусе КТ-2-7 ГОСТ 18472-82, предназначенные для работы в усилителях мощности, в торичных источниках питания, преобразователях и другой аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ

Схема расположения выводов



КТД 2Т830 - 8/10/88

Основные электрические параметры при $T_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Граничное напряжение, В 2Т830А 2Т830Б 2Т830В 2Т830Г ($J_3 = 0,1 \text{ A}, Q > 100, t_{\mu} \leq 300 \text{ мкс}$)	$U_{к30 гр}$	25	
		45	
		60	
		80	
Пробивное напряжение коллектор-база, В 2Т830А 2Т830Б 2Т830В 2Т830Г ($J_к = 0,1 \text{ mA}$)	$U_{к50 проб}$	35	
		60	
		80	
		100	
Пробивное напряжение эмиттер-база, В 2Т830А 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г ($J_3 = 1 \text{ mA}$)	$U_{350 проб}$	12	
		5	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г ($J_к = 1 \text{ A}, J_3 = 0,1 \text{ A}$)	$U_{кэ нас}$		0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, В 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г ($J_к = 1 \text{ A}, J_3 = 0,1 \text{ A}$)	$U_{бэ нас}$		1,3
Статистический коэффициент передачи тока 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В 2Т830Г ($U_{к5} = 1 \text{ В}, J_3 = 1 \text{ A}$)	$h_{21э}$	20	20

Основные электрические параметры
при $t_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквен- ное обозначе- ние	Н о р м а	
		не менее	не более
Граничное напряжение, В 2Т830А 2Т830Б 2Т830В 2Т830Г ($J_3 = 0,1 \text{ А}, Q > 100, t_u \leq 300 \text{ мкс}$)	$U_{к30 гр}$	25 45 60 80	
Пробивное напряжение коллектор- -база, В 2Т830А 2Т830Б 2Т830В 2Т830Г ($J_k = 0,1 \text{ мА}$)	$U_{к50 проб}$	35 60 80 100	
Пробивное напряжение эмиттер- -база, В 2Т830А 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г ($J_3 = 1 \text{ мА}$)	$U_{э50 проб}$	12 5	
Напряжение насыщения коллектор- -эмиттер, В 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г ($J_k = 1 \text{ А}, J_5 = 0,1 \text{ А}$)	$U_{кэ нас}$		0,6
Напряжение насыщения база- -эмиттер, В 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г ($J_k = 1 \text{ А}, J_5 = 0,1 \text{ А}$)	$U_{бэ нас}$		1,3
Статический коэффициент передачи тока 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В 2Т830Г ($U_{кб} = 1 \text{ В}, J_3 = 1 \text{ А}$)	$h_{21э}$	25 20	